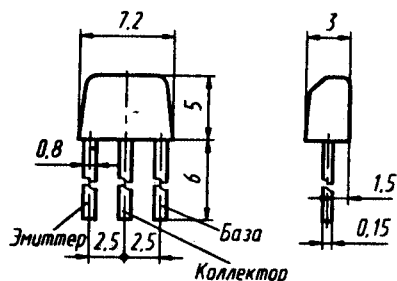


КТ361А, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е

КТ361(А-Е)



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Изготовители — акционерное общество «Кремний», г. Брянск, завод при НИИПП, г. Томск.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока

в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В, $I_k = 1$ мА:

$T = +25$ °С:

КТ361А, КТ361Д.....	20...90
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е	50...350
КТ361В.....	40...160

$T = +100$ °С:

КТ361А, КТ361Д.....	20...250
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е	50...500
КТ361В.....	20...300

$T = -60$ °С:

КТ361А, КТ361Д.....	10...90
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е	15...350
КТ361В.....	10...160

Граничная частота коэффициента передачи

тока при $U_{кз} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА, не менее..... 250 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи

при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 5$ МГц, не более:

КТ361А, КТ361Б, КТ361Г	500 пс
КТ361В, КТ361Е.....	1000 пс
КТ361Д.....	250 пс

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 10$ В,

не более:

$T = +25$ и -60 °С	1 мкА
$T = +100$ °С	25 мкА

Обратный ток коллектор—эмиттер

при $R_{бз} = 10$ кОм, $U_{кз} = U_{кз, макс}$, не более..... 1 мкА

Емкость коллекторного перехода

при $U_{кб} = 10$ В, не более:

КТ361А, КТ361Б	9 пФ
КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е.....	7 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор—база,

коллектор—эмиттер¹ при $R_{бз} = 10$ кОм:

$T \leq +35$ °С:

КТ361А	25 В
--------------	------

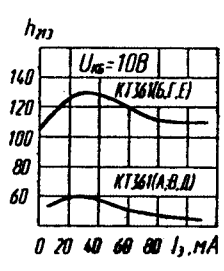
¹ В диапазоне температур $+35...+100$ °С допустимое значение напряжения коллектор—эмиттер снижается линейно.

КТ361Б.....	20 В
КТ361В, КТ361Д.....	40 В
КТ361Г, КТ361Е.....	35 В
$T = +100\text{ }^\circ\text{C}$:	
КТ361А.....	20 В
КТ361Б.....	15 В
КТ361В, КТ361Д.....	35 В
КТ361Г, КТ361Е.....	30 В
Постоянное напряжение база—эмиттер.....	4 В
Постоянный ток коллектора.....	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ :	
$T \leq +35\text{ }^\circ\text{C}$	150 мВт
$T = +100\text{ }^\circ\text{C}$	30 мВт
Температура р-п перехода.....	+120 °С
Температура окружающей среды.....	-60...+100 °С

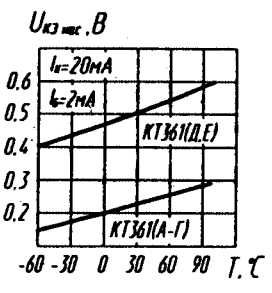
¹ В диапазоне температур +35...+100 °С допустимое значение рассеиваемой мощности снижается линейно.

Допускается трехкратный изгиб выводов не ближе 2 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм.

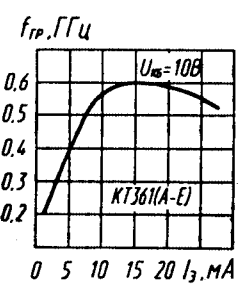
Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса 2 мм.



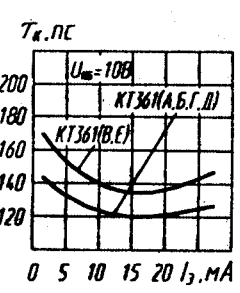
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер от температуры



Зависимость граничной частоты от тока эмиттера



Зависимости постоянного времени цепи обратной связи от тока эмиттера